文章编号: 0258-7025(2008)04-0601-04

利用窄得-奥菲特理论研究 Tm:Lu₂SiO₅ 晶体的光谱特性

姚宝权1 郑亮亮1 赵广军2 宗艳花2

(¹哈尔滨工业大学可调谐激光技术国家级重点实验室,黑龙江哈尔滨 150001 2中国科学院上海光学精密机械研究所激光与光电子功能材料研究中心,上海 201800)

摘要 采用丘克拉斯基(Czochralski)技术生长了掺铥硅酸镥(Tm:Lu₂SiO₅,Tm:LSO)晶体;测量了 LSO 晶体在室 温下的非偏振吸收光谱和非偏振荧光光谱;利用窄得-奥菲特(Judd-Ofelt)理论计算了 Tm:LSO 晶体的窄得-奥菲 特强度参数、振子强度、自发辐射概率、辐射寿命、积分吸收截面和积分发射截面。Tm:LSO 晶体的强度参数为 Ω_2 =9.1355×10⁻²⁰ cm², Ω_4 =8.4103×10⁻²⁰ cm², Ω_6 =1.5908×10⁻²⁰ cm²;Tm:LSO 晶体在1.9 μ m附近有明显的 发射峰(${}^{3}F_{4} \rightarrow {}^{3}H_{6}$ 跃迁),相应的辐射寿命为2.03 ms,积分发射截面为5.81×10⁻¹⁸ cm²,半峰全宽(FWHM)为 250 nm。用 Tm:LSO 晶体在77 K温度下实现了激光运转。利用792 nm的激光二极管(LD)作为抽运源,获得中心 波长为1960 nm的激光输出,抽运阈值为2.13 kW/cm²。

关键词 激光器;固体激光器;激光材料;窄得-奥菲特理论;铥离子;斯塔克能级 中图分类号 O 734;TN 244;TN 248.1 **文献标识码** A

Judd-Ofelt Analysis of Spectroscopic Properties of Tm³⁺ Doped Lu₂SiO₅ Crystals

Yao Baoquan¹ Zheng Liangliang¹ Zhao Guangjun² Zong Yanhua²

 ¹ National Key Laboratory of Tunable Laser Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China
 ² R&D Center for Laser and Opto-Electronic Materials, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China

Abstract A new silicate laser crystal, Tm: Lu₂SiO₅ (Tm: LSO) crystal, has been obtained by the Czochralski technology. Absorption spectra and fluorescence (un-polarized) spectra of Tm: LSO have been measured at room temperature. Parameters such as Judd-Ofelt intensive parameters, oscillator strength, spontaneous radiation rate, fluorescence lifetime, integrated absorption cross-section, integrated emission cross-section were calculated by Judd-Ofelt theory. Intensive parameters were calculated to be $\Omega_2 = 9.1355 \times 10^{-20}$ cm², $\Omega_4 = 8.4103 \times 10^{-20}$ cm², $\Omega_6 = 1.5908 \times 10^{-20}$ cm². Some main emission peaks exist around 1.9 μ m, corresponding to ${}^{3}F_{4} \rightarrow {}^{3}H_{6}$ transition. Fluorescence lifetime and integrated emission cross-section, corresponding to ${}^{3}F_{4} \rightarrow {}^{3}H_{6}$ transition, were calculated to be 2.03 ms and 5.81×10⁻¹⁸ cm², respectively. Laser actions have been obtained by use of Tm: LSO crystal at the temperature of 77 K. The central laser wavelength of 1960 nm and pumping threshold of 2.13 kW/cm² were obtained.

Key words lasers; solid-state lasers; laser material; Judd-Ofelt theory; Tm ions; Stark energy level

1 引 言

2 μm 波长处于水的强吸收带、人眼安全区和大 气的弱吸收带,可以广泛应用于空间遥感(如多普勒 风速监测雷达和大气水分差分吸收雷达)、医疗(如 关节镜检查、碎石术、骨科和血管成形术)、光谱学和 基础研究等领域,也可以作为光学参量振荡(OPO)

收稿日期:2007-08-16; 收到修改稿日期:2007-11-01

作者简介:姚宝权(1970—),男,辽宁人,副研究员,博士,主要从事固体激光器及非线性频率转换技术的研究。 E-mail:yaobq08@126.com

光

和光学参量放大(OPA)的抽运源,实现更长波段的 中红外输出^[1]。

Tm³⁺可以掺杂在多种基质中实现2μm波长激 光输出^[2~10]。掺铥硅酸镥Tm:Lu₂SiO₅(LSO)晶体 属于稀土正硅酸盐类单斜晶系,空间群为 $C2/c(C_{2h}^{6})$,密度为7.4g/cm³,熔点为2100℃左右, 晶格常数为a = 1.2368(4) nm,b = 0.6632(0) nm, c=1.0255(9) nm, $\beta = 102.50(6)^{\circ}$ 。LSO 晶体具有 较大的热导率(k = 5.3 W/(m·K)),能有效冷却 晶体,降低热效应对输出功率的影响。本文测量了 常温下Tm:LSO 的非偏振吸收光谱和非偏振荧光 光谱;利用窄得-奥菲特(Judd-Ofelt)^[11]理论计算了 晶体的强度参数以及一些能级的极化振子强度、自 发辐射跃迁概率、辐射寿命、积分吸收截面和积分发 射截面等参数;并在77 K温度下实现了激光输出。

2 光谱参数的计算和讨论

Tm:LSO 由中国科学院上海光学精密机械研究所采用提拉法生长。Tm 离子的原子数分数为4%,样品折射率为1.82,尺寸为3 mm×3 mm×8 mm。室温下测得 Tm:LSO 的非偏振吸收光谱和非偏振荧光光谱分别如图1(a),(b)所示。

三价自由稀土离子的 4 f^N 组态的电子波函数具 有相同的宇称,没有电偶极辐射和吸收。当三价稀 土离子掺入晶体后,稀土离子发光主要是电偶极跃 迁,磁偶极跃迁对谱线强度贡献不大,与电场相比要 弱近一个数量级,所以计算时将其忽略,只考虑电偶 极情况。

吸收跃迁的振子强度为[12]

$$f_{\rm exp} = \frac{1}{N} \frac{m_{\rm e} c}{\pi e^2} \int k(\mathbf{y}) \,\mathrm{d}\mathbf{y}, \qquad (1)$$

式中*m*_e,e分别为电子的质量和电荷,c为光速,N为 单位体积内的激活离子数,k(ν)为晶体对频率为 ν 的光的吸收系数,将(1)式按波长 λ 写出,可得



Fig. 1 Room-temperature absorption (unpolarized) spectra (a) and fluorescence (unpolarized) spectra (b) of 4% Tm:LSO

$$f_{\rm exp} = \frac{1}{N} \frac{m_{\rm e} c^2}{\pi e^2} \int k(\lambda) / \lambda^2 \,\mathrm{d}\lambda, \qquad (2)$$

厚度为L的测试样品,光密度O与吸收截面σ_{abs}之间 的关系为

$$\sigma_{\rm abs} = 2.303 \times (L \times N)^{-1} \times O, \qquad (3)$$

利用(2),(3)式和图 1 的吸收光谱,求出 Tm:LSO 晶体各吸收跃迁的振子强度 f_{exp} 和吸收截面 σ_{abs} ,结果列于表 1。

根据窄得-奥菲特理论, Tm³⁺ 电子组态的 *SLJ* 能级向 *S'L'J'* 能级发生电偶极矩跃迁的谱线强度 *S*_{JJ} 可表示为

$$S_{JJ'} = \sum_{t=2,4,6} \Omega_t \left| \langle 4f^N(SL)J \rangle \left| U^{(t)} \right| \langle 4f^N(S'L')J' \rangle \right|^2,$$
(4)

表 1 主要吸收峰相应于 Tm^{3+} 基态 ${}^{3}H_{6}$ 的能级跃迁 Table 1 Main absorption peaks corresponding to the transitions of Tm^{3+} ions from the ${}^{3}H_{6}$ ground state

Excited state	Wavelength range /nm	Peak wavelength /nm	$\sigma_{\rm abs} \ / (10^{-20} \ {\rm cm}^2)$	$f_{ m exp} \ /10^{-6}$
$^{3}P_{2}$	$250 \sim 268$	260	1.51	14.4178
3P_0	$280 \sim 304$	290	0.88	9.7427
$^{1}D_{2}$	$340 \sim 374$	356	1.29	10.2149
${}^{\scriptscriptstyle 3}F_{\scriptscriptstyle 3}$	$664 \sim 690$	678	1.76	3.3166
3H_4	782~838	790	1.68	4.0543
$^{3}H_{5}$	$1192 \sim 1218$	1206	1.85	2.4210
3F_4	$1710 \sim 1722$	1716	1.44	3.0090



式中 $\Omega_t(t = 2, 4, 6)$ 为唯像强度参数,取决于基质材料的配位特性,J和J'为跃迁初态和末态的总角动量, $|\langle 4f^N(SL)J \rangle | U^{(i)} | \langle 4f^N(S'L')J' \rangle |$ 为约化矩阵元,只与掺杂离子有关,基本不随基质的变化而变化。Tm³⁺的约化矩阵元可由文献[13,14]查得。

考虑电偶极跃迁下的理论振子强度 f。可表示为

$$f_{\rm e} = \frac{8\pi^2 m_{\rm e} c}{3h\overline{\lambda} (2I+1)} \frac{(n^2+2)^2}{9n} S_{JJ'}, \qquad (5)$$

式中n为晶体的折射率,h为普朗克常数, $\overline{\lambda}$ 为跃迁 平均波长。

利用(2)~(5)式和图 1(a),可以得到 Tm:LSO 的晶场唯像强度参数 Ω_t 为 $\Omega_2 = 9.1355 \times 10^{-20}$ cm²,

 $\Omega_4 = 8.4103 \times 10^{-20} \text{ cm}^2, \Omega_6 = 1.5908 \times 10^{-20} \text{ cm}^2,$ 如表 2^[13~16]所示,与其他掺 Tm³⁺离子晶体相比,Tm:LSO 晶体有较大的唯像强度参数。一般来 $说,唯像强度参数 <math>\Omega_2$ 反映了基质配位场的对称性和 有序性, Ω_2 越大,基质的共价性越强;反之,离子性 越强。光谱质量因子 Ω_4/Ω_6 的比值代表了奇晶场项 的大小及跃迁分支比,比值越大,说明晶场的五次项 相对于三次项越小。Tm:LSO 晶体的光谱质量因 子小于 Tm:YAP 晶体,但大于表 2 所列其他晶体。 较大的 Ω_4/Ω_6 值预示着 Tm:LSO 晶体可能是产生 有效激光行为的很有前途的材料。

 $2_2 = 9.1355 \times 10^{-20} \text{ cm}^2$, 当稀土离子中的电子从激发态J'跃迁到基态J $= 2 \pm 2 \pm 7 \text{ m}^{3+}$ 离子不同晶体的唯傻强度参数和光谱质量因子

	1 -	19 1111		FF-11-正际1-	L D D X T	小山伯灰皇	, Fei J	
Table 2	Intensive	paramete	rs and spect	ral factor o	of merit of	different	Tm-doped	crystals

Crystal	$\Omega_2 / (10^{-20} \text{ cm}^2)$	$\Omega_4 / (10^{-20} \text{ cm}^2)$	$\Omega_6 / (10^{-20} \text{ cm}^2)$	$oldsymbol{\Omega}_4/oldsymbol{\Omega}_6$
YLF	1.67	1.93	1.10	1.75
YAG	0.70	1.20	0.50	2.40
YAP	1.46	2.07	0.32	6.47
GdVO_4	8.16	2.45	0.98	2.50
LSO	9.14	8.41	1.59	5.29

(7)

时,自发跃迁概率 $A_{JJ'}$ 、谱线强度 $S_{JJ'}$ 以及辐射寿命 τ 的关系为

$$A_{JJ'}[(S',L')J';(S,L)J] = \frac{64\pi^4 e^2}{4h\lambda^3} \frac{n(n^2+2)^2}{9(2J'+1)} S_{JJ'},$$
(6)

 $au = 1/A_{JJ'}$,

积分发射截面为

$$\int \sigma(\nu) d\nu = \frac{\lambda^2}{8\pi c n^2} A_{JJ'}, \qquad (8)$$

利用(6)~(8)式,可以计算出晶体中 Tm³⁺的自发 辐射跃迁概率、积分发射截面和辐射寿命等参数,结 果列于表 3。

表 3 LSO 晶体的自发辐射跃迁概率、辐射寿命和

积分发射截面

Table 3 Spontaneous radiation rate, radiative lifetime and integrated emission cross-section of Tm:LSO crystal

Transitions	$\lambda \ /nm$	$A_{ m cal}~/{ m s}^{-1}$	$ au/\mu s$	$\sigma_{\rm em} \ / \ (10^{-18} \ { m cm}^2)$
${}^{3}P_{2}$	260	47124	21	12.76
${}^{3}P_{0}$	290	25596	39	8.63
1D_2	356	17808	56	9.04
${}^{3}F_{3}$	678	1594	627	2.94
$^{3}H_{4}$	790	1435	697	3.59
$^{3}H_{5}$	1206	368	2720	2.14
3F_4	1716	225	2030	5.81

从图 1(a)可以看出, Tm³⁺的吸收光谱在 472 nm, 790 nm和1716 nm附近出现小分叉, 这是跃 迁终态斯塔克(Stark)能级劈裂造成的;在678 nm, 790 nm和1206 nm附近有较强的吸收峰,对应的吸 收截面分别为 1.76×10^{-20} cm², 1.68×10^{-20} cm²和 1.85×10^{-20} cm²,该晶体较大的吸收截面有利于高 效率抽运。

从图 1(b)可以看出,Tm:LSO 晶体的非偏振荧 光光谱覆盖了1576~2090 nm,半峰全宽(FWHM) 高达250 nm,在1.9 μm附近有明显的发射峰,对应 的积分发射截面为5.81×10⁻¹⁸ cm²,辐射寿命为 2.03 ms。与其他晶体相比,对应于 ${}^{3}F_{4} \rightarrow {}^{3}H_{6}$ 能级 跃迁,Tm:LSO 晶体具有较大的积分发射截面和较 长的辐射寿命(见表 4^[16~18])。Tm³⁺在 LSO 晶体强 的晶场耦合作用下产生斯塔克能级劈裂。长辐射寿 命和较大的积分发射截面有利于 Tm:LSO 在2 μm 波长实现高效率激光输出。

表 4 掺 Tm³⁺离子不同晶体对应于 ³F₄ → ³H₆ 能级跃迁 的积分发射截面和辐射寿命

Table 4 Integrated emission cross-section and radiative lifetime corresponding to ${}^{3}F_{4} \rightarrow {}^{3}H_{6}$ transition of different Tm-doped crystals

Crystals	$\sigma_{\rm em} \ /(10^{-18} \ {\rm cm}^2)$	τ/ms
YAG	1.49	1.73
YAP	2.22	1.03
GdVO_4	_	1.24
LSO	5.81	2.03

3 实 验

实验采用"L"形谐振腔,实验装置如图 2 所示。 抽运源激光二极管(LD)为光纤耦合输出,光纤芯径 为200 μ m,数值孔径为0.22。激光二极管额定功率 为25 W,中心波长为793.4 nm。与侧面抽运方式相 比,端面抽运很容易实现抽运光和振荡激光模式的 良好匹配。耦合镜 L_1,L_2 的焦距分别为25 mm, 51 mm。 M_1 和 M_2 对抽运光高透,对1.94 μ m激光高 反。输出镜 M_3 的曲率半径为200 mm,透过率为 2.5%。Tm:LSO 晶体端面尺寸为3 mm×3 mm× 8 mm,Tm³⁺的原子数分数为4%。晶体装在紫铜 热沉上,置于杜瓦瓶内用液氮制冷。腔长为70 mm 左右。



图 2 激光二极管抽运 Tm:LSO 激光器示意图 Fig. 2 Configuration of LD pumped Tm:LSO laser





当注入功率为 6.47 W 时,获得332 mW,中心 波长为1.96 μm的激光输出,斜率效率为11.5%,抽 运阈值为2.12 kW/cm²,如图 3 所示。

4 结 论

通过测量和研究 Tm:LSO 的非偏振吸收光谱 和非偏振荧光光谱发现,利用窄得-奥菲特理论拟合 得出晶场唯像晶格参数,并且得到了表征激光输出 性能的积分发射截面、辐射寿命和极化振子强度等 光谱参数;Tm:LSO 晶体具有较宽的发射带,非常 有利于2 μm波长可调谐激光输出;Tm³⁺在 LSO 晶 体强的晶场耦合作用下产生斯塔克能级劈裂,同时 ³F₄能级具有较大的辐射寿命,使得 Tm:LSO 晶体 可能在2 μm波长实现高效率激光输出。总之,Tm: LSO 晶体具有较大的积分吸收截面和积分发射截 面,³F₄能级具有较长的辐射寿命,可能成为2 μm波 长激光输出的新材料。

参考文献

- 1 Valenin Petrov, Junhai Liu, Miguel Galan et al.. Efficient diode-pumped cw Tm:KLu(WO₄)₂ laser [C]. SPIE, 2006, 6216;62160K
- 2 B. T. McGuckin, R. T. Menzies, H. Hemmati. Efficient energy extraction from a diode-pumped Q-switched Tm, Ho: YLiF₄ laser [J]. Appl. Phys. Lett., 1991, **59**(23):2926~ 2928
- 3 Jeffrey D. Kmetec, Tracy S. Kubo, Thomas J. Kane *et al.*. Laser performance of diode-pumped thulium-doped Y₃Al₅O₁₂, (Y, Lu)₃Al₅O₁₂, and Lu₃Al₅O₁₂ crystals [J]. Opt. Lett., 1994, **19**(3):186~188
- 4 Yufeng Li, Baoquan Yao, Yuezhu Wang et al.. High efficient diode-pumped Tm: YAP laser at room temperature [J]. Chin. Opt. Lett., 2007, 5(5):286~287
- 5 I. F. Elder, M. J. P. Payne. Lasing in diode-pumped Tm: YAP, Tm, Ho: YAP and Tm, Ho: YLF [J]. Opt. Commun., 1998, 145:329~339
- 6 P. A. Budni, M. L. Lemons, J. R. Mosto *et al.*. High-power/high-brightness diode-pumped 1.9 μm thulium and resonantly pumped 2.1 μm holmium lasers [J]. *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.*, 2000, **6**(4):629~635
- 7 Gianluca Galzerano, Francesco Cornacchia, Daniela Parisi et al.. Widely tunable 1.94-µm Tm: BaY₂F₈ laser [J]. Opt. Lett., 2005, 30(8):854~856
- 8 J. J. Zayhowski, J. Harrison, C. Dill Ill et al.. Tm: YVO₄ microchip laser [J]. Appl. Opt., 1995, 34(3):435~437
- 9 Chr. Wyss, W. Luthy, H. P. Weber *et al.*. Performance of a diode-pumped 1.4 W Tm: GdVO₄ microchip laser at 1.9 μm [C]. 1998 CLEO, 1998. 11
- 10 R. Lisiecki, P. Solarz, G. Dominiak-Dzik *et al.*. Comparative optical study of thulium-doped YVO₄, GdVO₄, and LuVO₄ single crystals [J]. *Phys. Rev. B*, 2006, **74**(3):035103
- 11 G. S. Ofelt. Intensities of crystal spectra of rare-earth ions [J]. J. Chem. Phys., 1962, 37(3):511~520
- 12 A. A. Kaminskii. Laser Crystal: Their Physics and Properties [M]. Berlin: SpringerVerlag, 1981. 19~20
- 13 W. T. Carnail, P. R. Fields, B. G. Wybourent. Spectral intensities of the trivalent lanthanides and actinides in solution. I. Pr^{3+} , Nd^{3+} , Er^{3+} , Tm^{3+} , and Yb^{3+} [J]. J. Chem. Phys., 1965, **42**(11):3797~3806
- 14 Brian M. Walsh, Norman P. Barnes, Baldassare Di Bartolo. Branching ratios, cross sections, and radiative lifetimes of rare earth ions in solids: Application to Tm³⁺ and Ho³⁺ ions in LiYF₄[J]. J. Appl. Phys., 1998, 83(5):2772~2787
- Lu Yanling, Yang Yang, Wang Jun et al.. Spectral properties of Tm: YAP laser crystal [J]. Chinese J. Lasers, 2006, 33(7): 968~972
 陆燕玲,杨 扬,王 俊等. Tm: YAP 激光晶体光谱参数的计
- 算[J]. 中国激光, 2006, 33(7):968~972
 Yanmin Yang, Baoquan Yao, Baojiu Chen *et al.*. Judd-Ofelt analysis of spectroscopic properties of Tm³⁺, Ho³⁺ doped
- GdVO₄ crystals [J]. Opt. Mater., 2007, 29(9):1159~1165
 John A. Caird, Larry G. Deshazer, John Nella. Characteristics of room-temperature 2. 3-µm laser emission from Tm³⁺ in YAG and YAIO₃ [J]. IEEE J. Quantum Electron., 1975, QE-11
- 18 M. J. Weber. Multiphonon relaxation of rare-earth ions in yttrium orthoaluminate [J]. Phys. Rev. B, 1973, 8(1):54~ 64

(11): 874~881